

DOUBLE-DIODE PENTODE for use as I.F. amplifier, detector and A.G.C. diode in carradio sets. The tube can be directly operated from a 6 V or 12 V storage battery

DOUBLE-DIODE PENTHODE pour l'utilisation comme amplificateur MF, comme détecteur et comme diode de C.A.V. dans récepteurs autoradio. On peut faire fonctionner le tube directement d'un accumulateur de 6 V ou de 12 V

DOPPELDIODE PENTODE zur Verwendung als ZF-Verstärker, Signalgleichrichter und A.L.R.-Diode in Autoempfängern. Die Röhre kann direkt von einer 6 V- oder 12 V-Batterie betrieben werden

Heating : indirect. Series or parallel supply

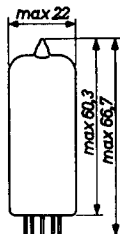
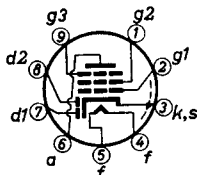
Chauffage: indirect. Alimentation série ou parallèle

Heizung : indirekt. Serien- oder Parallelspeisung

$$V_f = 6,3 \text{ V}$$

$$I_f = 300 \text{ mA}$$

Dimensions in mm  
Dimensions en mm  
Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: NOVAL

Capacitances  
Capacités  
Kapazitäten

Pentode section  
Partie penthode  
Pentodenteil

Diode sections  
Parties diode  
Diodenteile

$$C_a = 5,2 \text{ pF}$$

$$C_{d1} = 2,5 \text{ pF}$$

$$C_{g1} = 5,0 \text{ pF}$$

$$C_{d2} = 2,5 \text{ pF}$$

$$C_{ag1} < 0,0025 \text{ pF}$$

$$C_{d1d2} < 0,25 \text{ pF}$$

Between pentode and diode sections  
Entre les parties penthode et diode  
Zwischen Pentoden- und Diodenteilen

$$C_{d1g1} < 0,0008 \text{ pF}$$

$$C_{d2g1} < 0,001 \text{ pF}$$

$$C_{d1a} < 0,15 \text{ pF}$$

$$C_{d2a} < 0,025 \text{ pF}$$

Operating characteristics as I.F. amplifier  
 Caractéristiques d'utilisation comme amplificateur M.F.  
 Betriebsdaten als ZF-Verstärker

$V_a$	=	25	12,6	6,3 V
$V_{g3}$	=	0	0	0 V
$V_{g2}$	=	25	12,6	6,3 V
$V_{g1}$	=	1)	1)	1) V
$I_a$	=	1,7	0,45	0,12 mA
$I_{g2}$	=	0,5	0,14	0,04 mA
$S$	=	2,1	1,0	0,45 mA/V
$R_1$	=	0,2	1,0	0,65 M $\Omega$

Limiting values  
 Caractéristiques limites  
 Grenzdaten

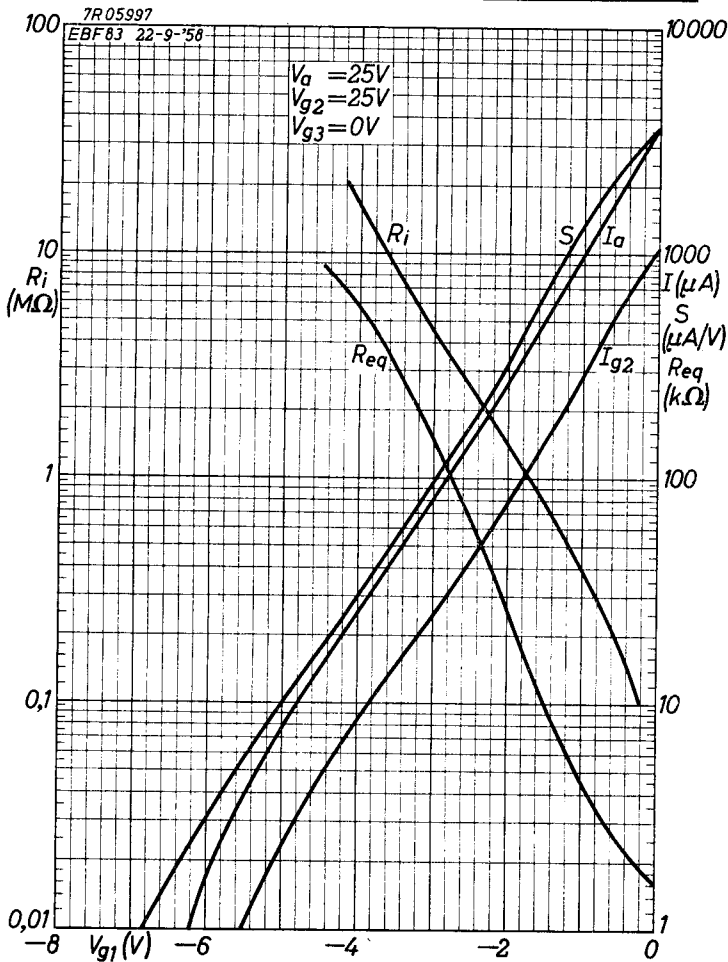
Pentode section  
 Partie penthode  
 Pentodenteil

$V_a$	= max.	50 V
$V_{g2}$	= max.	50 V
$I_k$	= max.	5 mA
$R_{g1}$	= max.	5 M $\Omega$
$V_{kr}$	= max.	50 V

Diode sections  
 Parties diode  
 Diodenteile

$I_{d1}$	= max.	0,8 mA
$I_{d2}$	= max.	0,8 mA
$I_{d1p}$	= max.	5 mA
$I_{d2p}$	= max.	5 mA

<sup>1</sup>) Obtained by grid current biasing;  $R_{g1} = 2.2 \text{ M}\Omega$   
 Obtenu par moyen de  $R_{g1} = 2,2 \text{ M}\Omega$   
 Erhalten mittels  $R_{g1} = 2,2 \text{ M}\Omega$

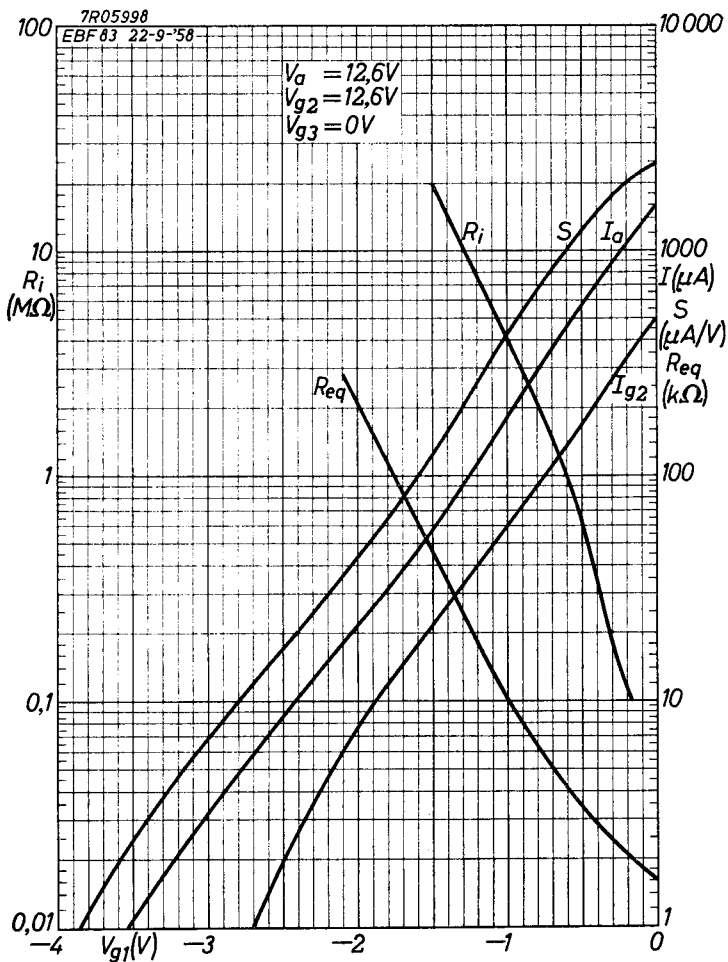


10.10.1958

A

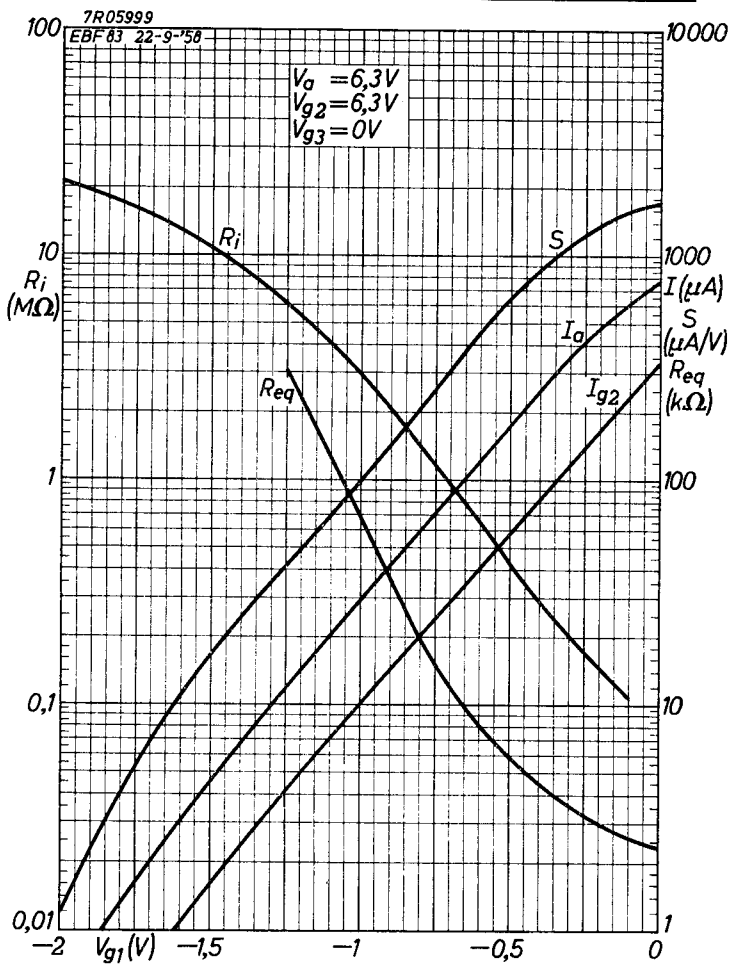
# PHILIPS

## EBF 83



# PHILIPS

# EBF 83



10.10.1958

C

**PHILIPS**



*Electronic  
Tube*

**HANDBOOK**

<b>page</b>	<b>EBF83 sheet</b>	<b>date</b>
1	1	1957.12.12
2	2	1957.12.12
3	A	1958.10.10
4	B	1958.10.10
5	C	1958.10.10
6	FP	1999.06.15